

# Silicon PIN Diode

## **BA779**

30V / 50mA

# DATASHEET

OEM – Telefunken

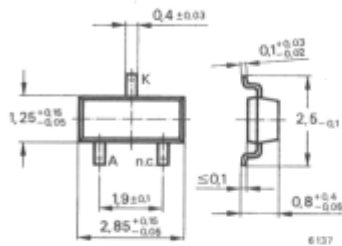
Source: Telefunken Databook 1988

**BA 779 · BA 779 S****Silizium-PIN-Dioden**

**Anwendungen:** Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken

**Besondere Merkmale:**

- Großer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz

**Abmessungen in mm**

Standard Kunststoffgehäuse  
23 A3 DIN 41869/8  
JEDEC TO 236  
SOT 23  
Gewicht max. 0,02 g

**Bestempellung:** BA 779 PN  
BA 779 S + PN

**Absolute Grenzdaten**

Sperrspannung	$U_R$	30	V
Durchlaßstrom	$I_F$	50	mA
Sperrschichttemperatur	$T_j$	125	°C
Lagerungstemperaturbereich	$T_{stg}$	- 55... + 125	°C

**Maximaler Wärmewiderstand**

Sperrschicht-Umgebung auf Leiterplatte 50 mm x 50 mm x 1,6 mm	$R_{thJA}$	500	K/W
--	------------	-----	-----

**Kenngößen.**

$T_{amb} = 25\text{ °C}$ , falls nicht anders angegeben

		Min.	Typ.	Max.	
Durchlaßspannung					
$I_F = 20\text{ mA}$	$U_F$			1	V
Sperrstrom					
$U_R = 30\text{ V}$	$I_R$			50	nA
Diodenkapazität					
$U_R = 0, f = 100\text{ MHz}$	$C_D$			0.5	pF
Differentieller Durchlaßwiderstand					
$I_F = 1.5\text{ mA}, f = 100\text{ MHz}$	$r_f$			50	Ω
Sperrimpedanz					
$U_R = 0, f = 100\text{ MHz}$	$z_r$		5		kΩ
	$z_r$		9		kΩ

**BA 779 · BA 779S**

